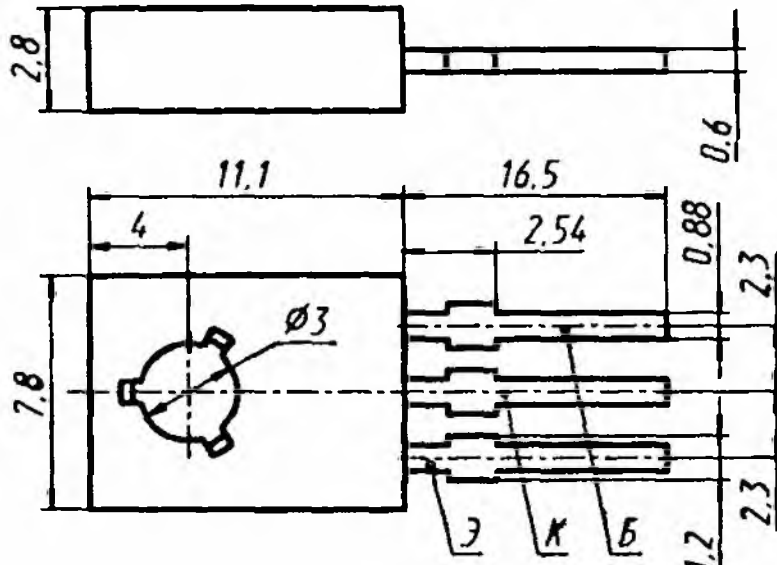


КТ9115А, КТ9115Б

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры *p-n-p* усилительные. Предназначены для применения в усилителях мощности высокой частоты. Выпускаются в пластмассовом корпусе с жесткими выводами. Тип прибора указывается на корпусе.

Масса транзистора не более 1 г.

КТ9115А



Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{кз} = 10$ В, $I_k = 30$ мА, не менее	25
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме ОЭ при $U_{кз} = 10$ В, $I_k = 30$ мА, не менее ..	90 МГц
Граничное напряжение при $I_k = 10$ мА, не менее:	
КТ9115А.....	300 В
КТ9115Б	150 В
Напряжение насыщения коллектор—эмиттер при $I_k = 30$ мА, $I_b = 6$ мА, не более	1 В
Напряжение насыщения база—эмиттер при $I_k = 30$ А, $I_b = 6$ мА, не более	1,1 В
Емкость коллекторного перехода при $U_{кб} = 30$ В, не более	5,5 пФ
типичное значение.....	2,5* пФ
Емкость эмиттерного перехода при $U_{бэ} = 0,5$ В, не более	50 пФ
типичное значение.....	35* пФ

Обратный ток коллектора при $U_{КБ} = 250$ В,
не более:

$T = +25$ °С	0,05 мкА
$T = +100$ °С	2 мкА

Обратный ток эмиттера при $U_{БЭ} = 3$ В,
не более

0,05 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор—база:

КТ9115А	300 В
КТ9115Б	150 В

Постоянное напряжение коллектор—эмиттер
при $R_{БЭ} \leq 10$ кОм:

КТ9115А	300 В
КТ9115Б	150 В

Постоянное напряжение база—эмиттер

5 В

Постоянный ток коллектора

0,1 А

Импульсный ток коллектора¹ при $t_{и} \leq 2$ мс,
 $Q \geq 3,3$

0,3 А

Постоянный ток базы

0,05 А

Постоянная рассеиваемая мощность коллек-
тора при $T_{к} = -45...+25$ °С:

с теплоотводом²

10 Вт

без теплоотвода³

1,2 Вт

Температура *p-n* перехода

+150 °С

Температура окружающей среды

-45... $T_{к} =$
= +100 °С

¹ При $Q < 3,3$ $T_{к, и, макс}$ рассчитывается по формуле

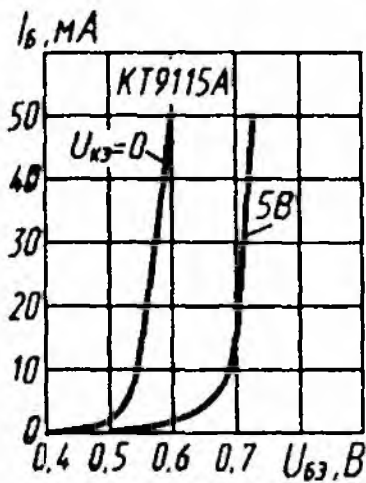
$$I_{к, и, макс} = I_{к, макс} Q, \text{ А.}$$

² При $T_{к} = +25...+100$ °С $P_{к, макс}$ снижается до 4 Вт.

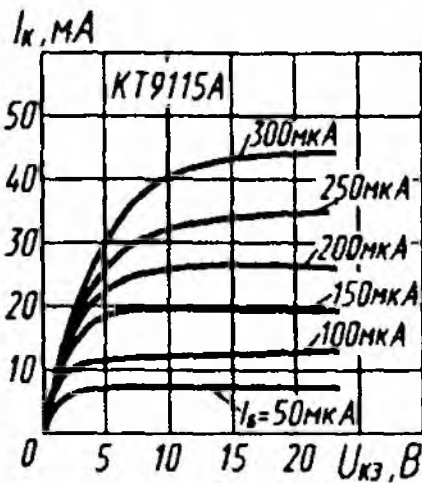
³ При $T = +25...+100$ °С $P_{к, макс}$ снижается до 0,48 Вт.

Пайка выводов рекомендуется не ближе 5 мм от корпуса транзистора при температуре припоя +265 °С в течение времени не более 3 с. Допускается пайка волной при температуре не более +235 °С.

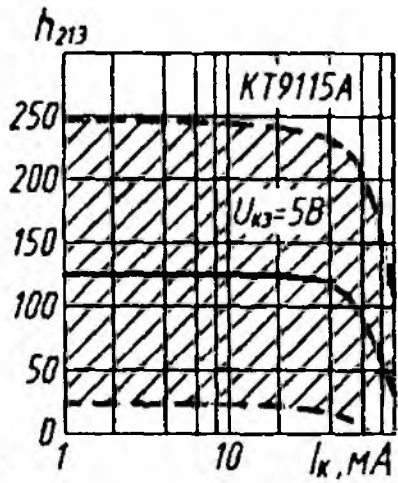
Допустимое значение статического потенциала 500 В.



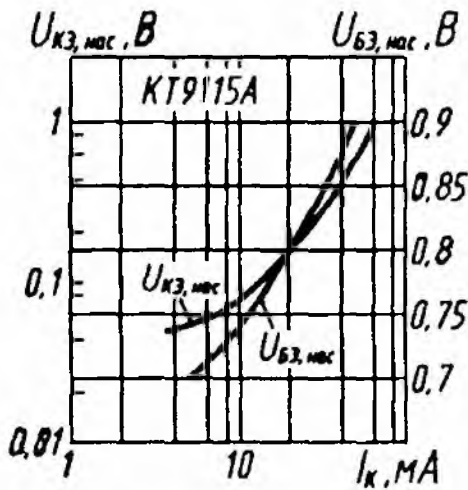
Входные характеристики



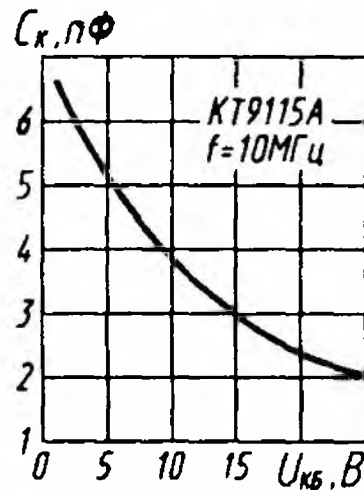
Выходные характеристики



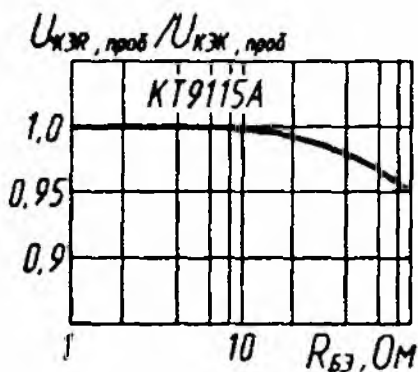
Зона возможных положений зависимости статического коэффициента передачи тока от тока коллектора



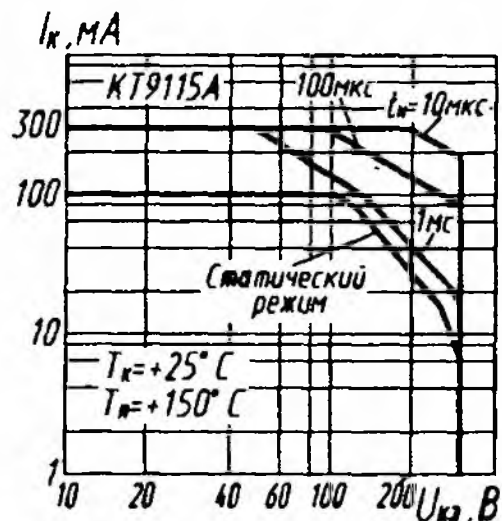
Зависимости напряжений насыщения коллектор—эмиттер и база—эмиттер от тока коллектора



Зависимость емкости коллекторного перехода от напряжения коллектор—база



Зависимость пробивного напряжения коллектор—эмиттер от сопротивления база—эмиттер



Области максимальных режимов